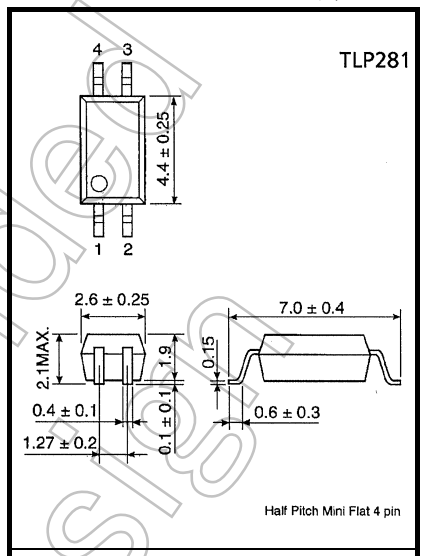
東芝フォトカプラ　赤外 LED +フォトトランジスタ

TLP281, TLP281-4

○ カードモデム、FAX モデムカード
○ プログラマブルコントローラ
○ 電位が異なる回路間の信号伝達

単位: mm



JEDEC	—
EIAJ	—
東芝	11-3A1

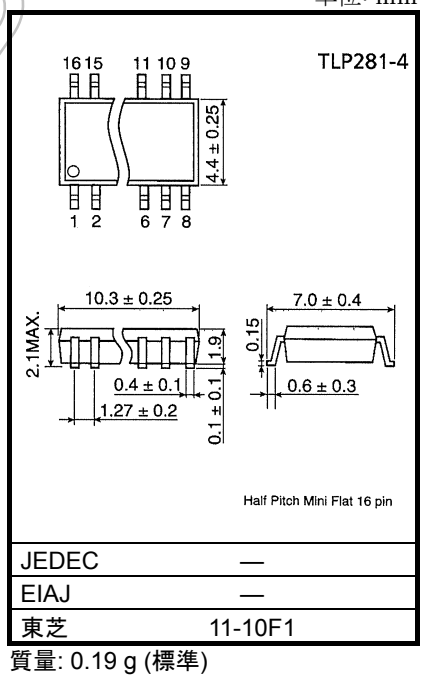
質量: 0.05 g (標準)

TLP281 シリーズは、フォトトランジスタと GaAs 赤外発光ダイオードを光結合させた超小型フラットパッケージの高耐ノイズ、高絶縁型のフォトカプラです。

このフォトカプラは、超小型・薄型です。1 チャネル品はハイブリット IC や PC モデムカードに適しています。4 チャネル品はハイブリット IC やプログラマブルコントローラに適しています。

- コレクタ・エミッタ間電圧 : 80 V (最小)
- 変換効率 : 50% (最小)
  GB ランク品 : 100% (最小)
- 絶縁耐圧 : 2500 Vrms (最小)
- UL 認定品 : UL1577、ファイル No. E67349
- BSI 認定品 : BS EN 60065: 2002
  : BS EN 60950-1: 2002
  認定書 No. 8143, 8144

単位: mm

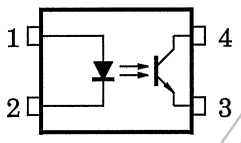


JEDEC	—
EIAJ	—
東芝	11-10F1

質量: 0.19 g (標準)

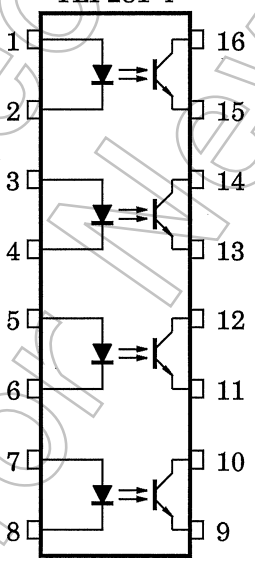
ピン接続図

TLP281



1 : アノード
2 : カソード
3 : エミッタ
4 : コレクタ

TLP281-4



1、3、5、7 : アノード
2、4、6、8 : カソード
9、11、13、15 : エミッタ
10、12、14、16 : コレクタ

Not Recommended for New Design

Start of commercial production
1996/03

変換効率

型名	分類名称 (注 1)	変換効率 (%) (I_C / I_F) I_F = 5 mA, V_{CE} = 5 V, Ta = 25℃		製品表示記号
		最小	最大	
TLP281	無	50	600	無印,Y■,YE,G,G■,GR,B,BL,GB
	Y ランク品	50	150	YE
	GR ランク品	100	300	GR
	BL ランク品	200	600	BL
	GB ランク品	100	600	GB
	YH ランク品	75	150	Y■
	GRL ランク品	100	200	G
	GRH ランク品	150	300	G■
	BLL ランク品	200	400	B
TLP281-4	無	50	600	無印, GB
	GB ランク品	100	600	GB

注 1: 製品形名を指定する場合、形名と分類名称を組み合わせてください。
製品適用例: TLP281 (GB)

注意 : 安全規格認定のための形名申請は標準製品形名を使用してください。
(適用例) TLP281 (GB): TLP281

絶対最大定格 (Ta = 25℃)

項目		記号	定格		単位
			TLP281	TLP281−4	
発光側	直流順電流	I_F	50		mA
	直流順電流低減率	ΔI_F /℃	−0.7 (Ta≧53℃)	−0.5 (Ta≧25℃)	mA /℃
	パルス順電流 (注 2)	I_{FP}	1		A
	直流逆電圧	V_R	5		V
	接合部温度	T_j	125		℃
受光側	コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80		V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V_{ECO}	7		V
	コレクタ電流	I_C	50		mA
	コレクタ損失 (1 回路)	P_C	150	100	mW
	コレクタ損失低減率 (Ta≧25℃) (1 回路)	ΔP_C /℃	−1.5	−1.0	mW /℃
	接合部温度	T_j	125		℃
動作温度		T_{opr}	−55～100		℃
保存温度		T_{stg}	−55～125		℃
はんだ付け温度		T_{sol}	260 (10 秒)		℃
許容損失 (1 回路)		P_T	200	170	mW
許容損失低減率 (Ta≧25℃) (1 回路)		ΔP_T /℃	−2.0	−1.7	mW /℃
絶縁耐圧 (注 3)		BV_S	2500		Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 2: パルス幅 100 μs 以下、周波数 100 Hz

注 3: AC、1 分間 R.H.≦60%
LED 側ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

Not Recommended for New Design

電気的特性 (Ta = 25℃)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	順電圧	V_F	I_F = 10 mA	1.0	1.15	1.3	V
	逆電流	I_R	V_R = 5 V	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	V = 0, f = 1 MHz		30	—	pF
受光側	コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)\ CEO}$	I_C = 0.5 mA	80	—	—	V
	エミッタ・コレクタ間降伏電圧	$V_{(BR)\ ECO}$	I_E = 0.1 mA	7	—	—	V
	暗電流 (注 6)	I_{CEO}	V_{CE} = 48 V	—	0.01	0.1	μA
			照度 (100 ℓx) (注 4)	—	2	10	
			V_{CE} = 48 V, Ta = 85℃	—	2	50	μA
			照度 (100 ℓx) (注 4)	—	4	50	
	端子間容量	C_{CE}	V = 0, f = 1 MHz	—	10	—	pF

注 4: 標準電球を用いて捺印面に照射

結合特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
変換効率	I_C / I_F	I_F = 5 mA, V_{CE} = 5 V	50	—	600	%
		GBランク品	100	—	600	
変換効率 (飽和)	I_C / $I_{F\ (sat)}$	IF = 1 mA, VCE = 0.4 V	—	60	—	%
		GBランク品	30	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ (sat)}$	I_C = 2.4 mA, I_F = 8 mA	—	—	0.4	V
		I_C = 0.2 mA, I_F = 1 mA	—	0.2	—	
		GBランク品	—	—	0.4	
コレクタオフ電流	$I_{C\ (off)}$	V_F = 0.7 V, V_{CE} = 48 V	—	—	10	μA

Not Recommended for New Design

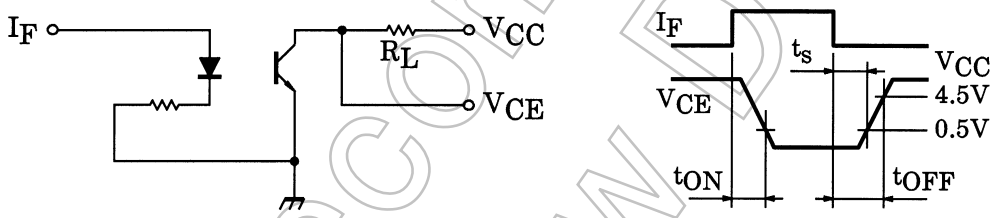
絶縁特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	C_S	V_S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R_S	V_S = 500 V, R.H.≦60%	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	AC、1 分間	2500	—	—	Vrms
		AC、1 秒間、オイル中	—	5000	—	
		DC、1 分間、オイル中	—	5000	—	Vdc

スイッチング特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
立ち上がり時間	t_r	V_{CC} = 10 V, I_C = 2 mA R_L = 100Ω	—	2	—	μs
立ち下がり時間	t_f		—	3	—	
ターンオン時間	t_{on}		—	3	—	
ターンオフ時間	t_{off}		—	3	—	
ターンオン時間	t_{ON}	R_L = 1.9 kΩ (注 5) V_{CC} = 5 V, I_F = 16 mA	—	2	—	μs
蓄積時間	t_s		—	25	—	
ターンオフ時間	t_{OFF}		—	40	—	

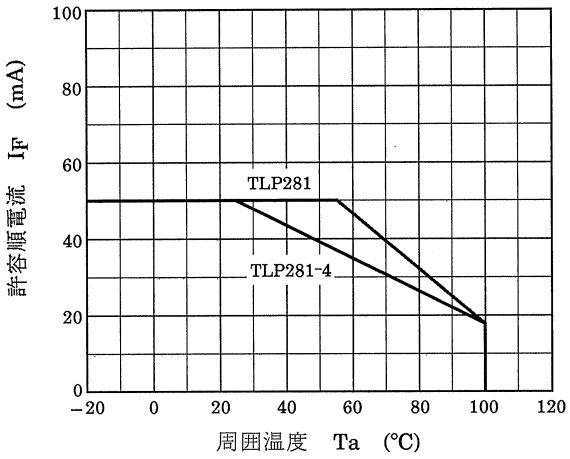
注 5: スイッチング時間測定回路



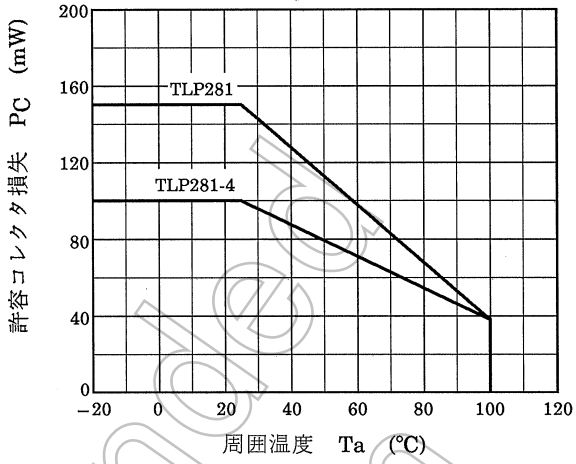
注 6: 本製品は構造上、外部からの光によってリーク電流が増加することがあります。
ご使用に際しては、外部からの光に十分ご注意願います。

Not Recommended for New Design

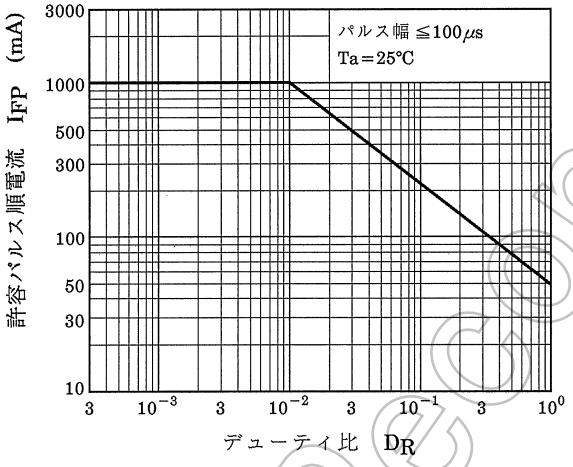
I_F – Ta



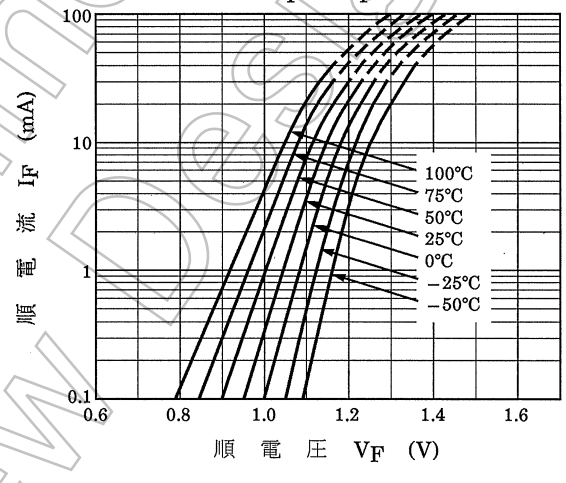
P_C – Ta



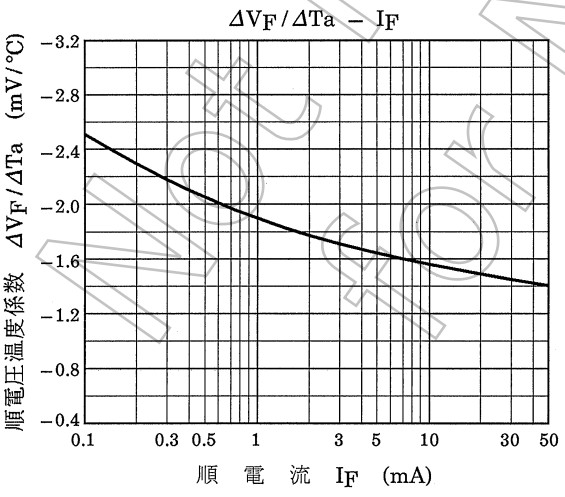
I_{FP} – D_R



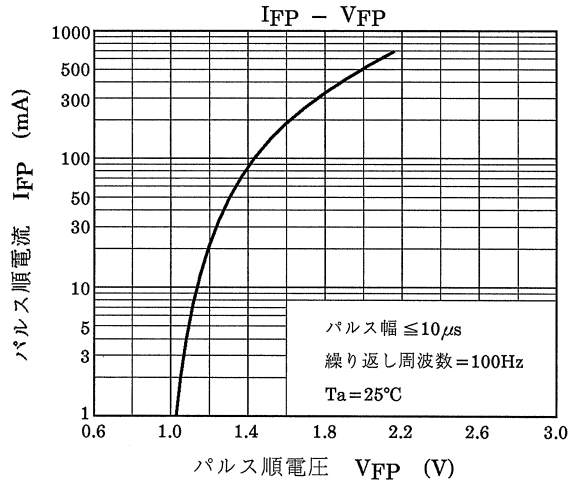
I_F – V_F



$\Delta V_F / \Delta Ta$ – I_F



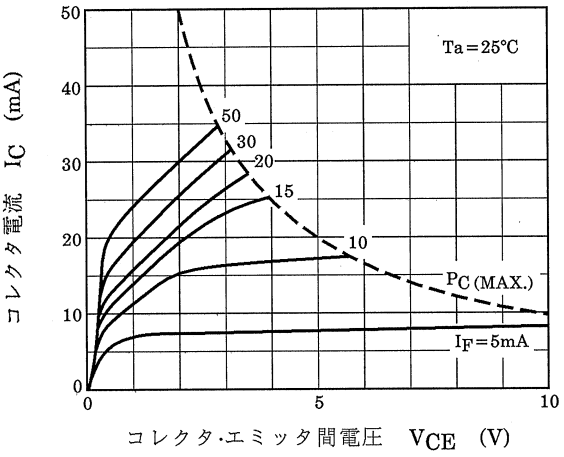
I_{FP} – V_{FP}



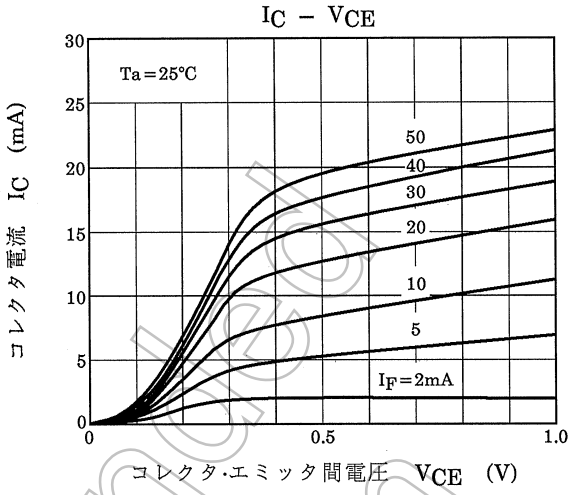
＊特性グラフは全て標準値

Not Recommended for New Design

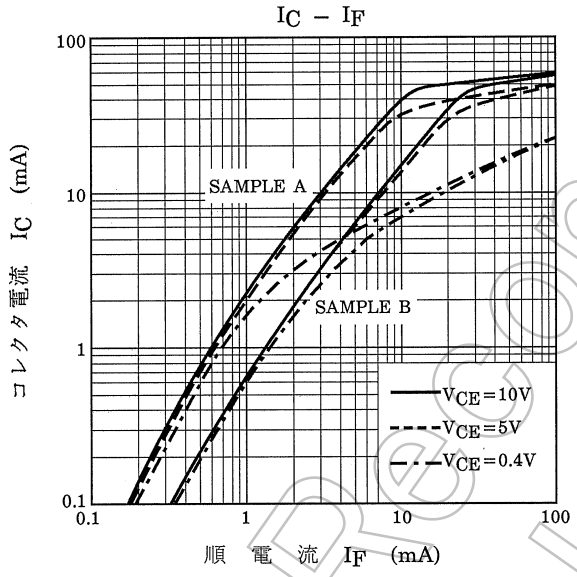
$I_C - V_{CE}$



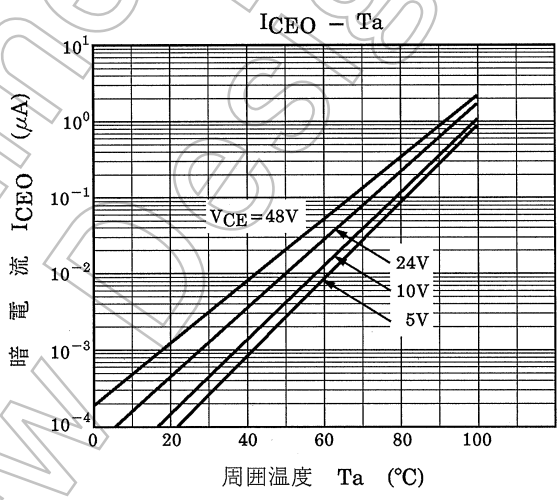
$I_C - V_{CE}$



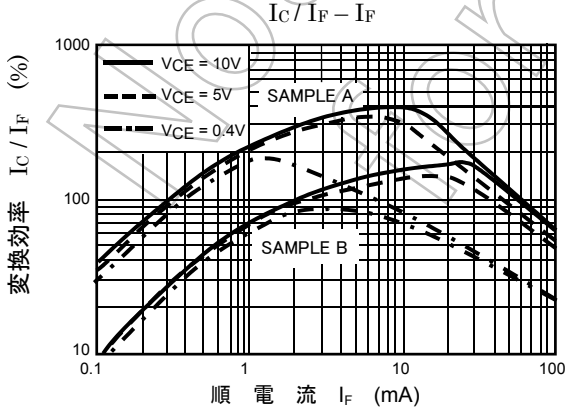
$I_C - I_F$



$I_{CEO} - Ta$



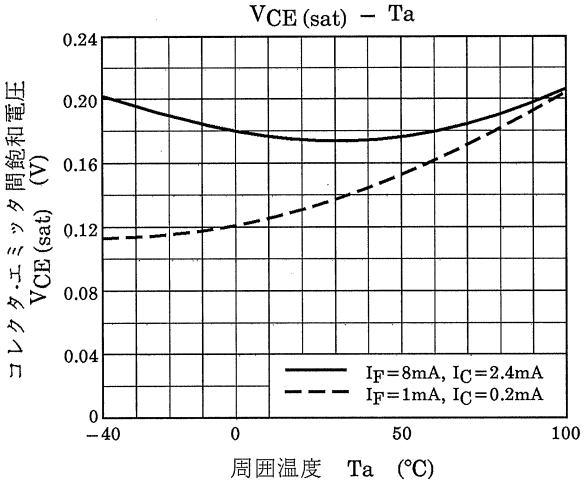
$I_C / I_F - I_F$



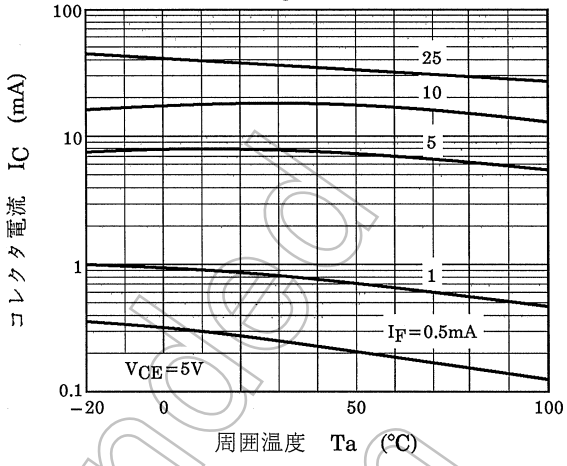
＊特性グラフは全て標準値

Not Recommended for New Design

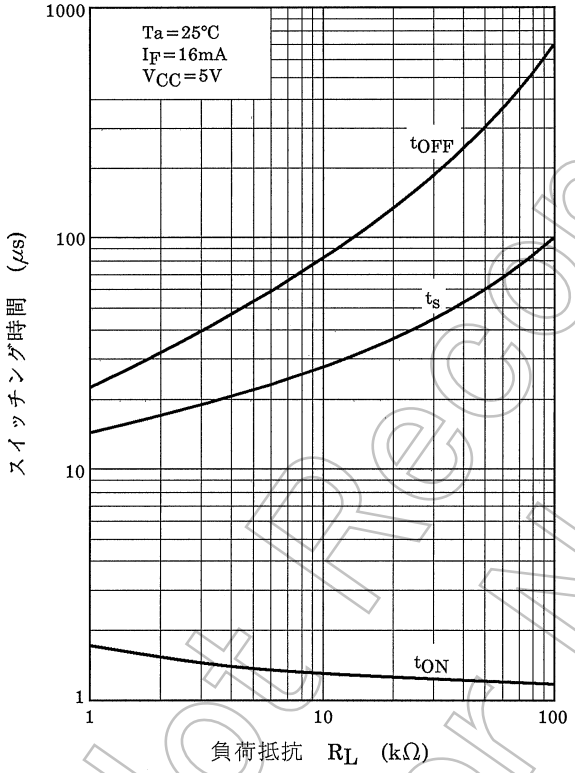
$V_{CE\,(sat)}$ – Ta



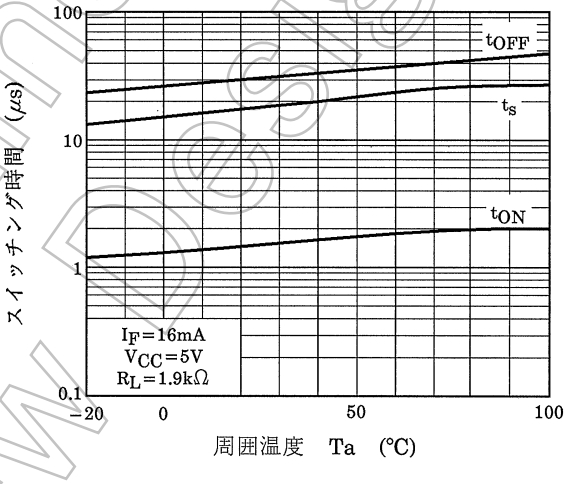
I_C – Ta



スイッチング時間 – R_L



スイッチング時間 – Ta



＊特性グラフは全て標準値

Not Recommended for New Design

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体･ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

Not Recommended for New Design